

Список публикаций оппонента Векслера Михаила Исааковича

1. Kardo-Sysoev,AF; Cherenev,MN; Lyublinsky,AG; Yusupova,SA; Belyakova,EI; Vexler,MI «The effect of DC bias and fast-rise pulse voltage on delayed impact ionization in a silicon diode structure», Microelectron. Eng., v.297, 2025, 112292
2. Грехов,ИВ; Векслер,МИ; Кардо-Сысоев,АФ; Коротков,СВ; Брылевский,ВИ; Люблинский,АГ; Родин,ПБ; Смирнова,ИА «Мощная импульсная полупроводниковая электроника нано- и субнаносекундного диапазона», В книге (сборнике): ФТИ им. А.Ф. Иоффе – 105 лет, 2023, с. 99 – 100
3. Illarionov,YY; Vexler,MI; Karner,M; Tyaginov,SE; Cervenka,J; Grasser,T «TCAD simulation of tunneling leakage current in $\text{CaF}_2/\text{Si}(111)$ MIS structures», Curr. Appl. Phys., v.15, 2, 2015, p. 78 – 83
4. Векслер,МИ; Тягинов,СЭ; Илларионов,ЮЮ; Yew Kwang_Sing; Ang Diing_Shenp; Федоров,ВВ; Isakov,D «Общая процедура расчета электрических характеристик туннельных МДП структур», ФТП, т.47, 5, 2013, с. 675 – 683
5. Сутурин,СМ; Банщиков,АГ; Соколов,НС; Тягинов,СЭ; Векслер,МИ «Статические вольт-амперные характеристики туннельных МДП структур $\text{Au}/\text{CaF}_2/\text{n-Si}(111)$ », ФТП, т.42, 11, 2008, с. 1333 – 1338
6. Grekhov,IV; Kareva,GG; Tyaginov,SE; Vexler,MI «Application of an MOS tunnel transistor for measurements of the tunneling parameters and of the parameters of electron energy relaxation in silicon», Microelectron. Reliab., v.47, 4-5 Spec., 2007, p. 669 – 672
7. Vexler,MI; El Hdiy,A; Grgec,D; Tyaginov,SE; Khilil,R; Meinerzhagen,B; Shulekin,AF; Grekhov,IV «Tunnel charge transport within silicon in reversely-biased MOS tunnel structures», Microelectron. J., v.37, 2, 2006, p. 114 – 120
8. Vexler,MI «Simulation of current-voltage characteristics of a MOS structure considering the tunnel transport of carriers in semiconductor», J. Phys. D-Appl. Phys., v.39, 1, 2006, p. 61 – 65
9. Шулекин,АФ; Тягинов,СЭ; Khilil,R; El Hdiy,A; Векслер,МИ «Мягкий пробой как причина спада тока в туннельной МОП структуре», ФТП, т.38, 6, 2004, с. 753 – 756
10. Grekhov,IV; Shulekin,AF; Tyaginov,SE; Vexler,MI «Soft breakdown in the bistable MOS tunnel structures», В книге (сборнике): Proceedings of the 8th International Symposium «Nanostructures: Physics and Technology», 2000, p. 502 – 505, St. Petersburg, Russia, June 19-23, 2000